

عنوان مقاله:

ترانزیستورهای اثر میدانی آلی با گیت دی الکتریک نانو کامپوزیت هیبریدی اکسید نیکل/ پلی وینیل پیرولیدین

محل انتشار:

اولین همایش تخصصی علوم ، فناوری و سامانه های مهندسی برق (سال: 1392)

تعداد صفحات اصل مقاله: 5

نویسندگان:

مریم درخشی - دانشگاه مازندران، علوم پایه، کارشناسی ارشد گروه فیزیک

محدثه جمالی - دانشگاه مازندران، علوم پایه، کارشناسی ارشد گروه فیزیک،

علی بهاری - دانشگاه مازندران، علوم پایه، عضو هیئت علمی گروه فیزیک،

خلاصه مقاله:

در کار حاضر اکسید نیکل به روش سل ژل سنتز شده، و پلی وینیل پیرولیدین با نسبت وزنی 2 و 21 به اکسید نیکل اضافه شده است. ویژگی نانوکامپوزیت های به دست آمده با استفاده از تکنیکهای میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش پرتو ایکس (XRD) و نرم افزار X-Powder مورد ارزیابی قرار گرفته شد. نتایج نشان داده است نانو کامپوزیت اکسید نیکل/ پلی وینیل پیرولیدین با نسبت وزنی 2:2 به دلیل دارا بودن مورفولوژی سطح خوب و استحکام مکانیکی بالا با توجه به رابطی هال پچ نمونهی بهتری برای جایگزینی در گیت دی الکتریک ترانزیستور است

کلمات کلیدی:

گیت دی الکتریک، نانو کامپوزیت هیبریدی، ترانزیستورهای اثر میدانی آلی

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/221021>

